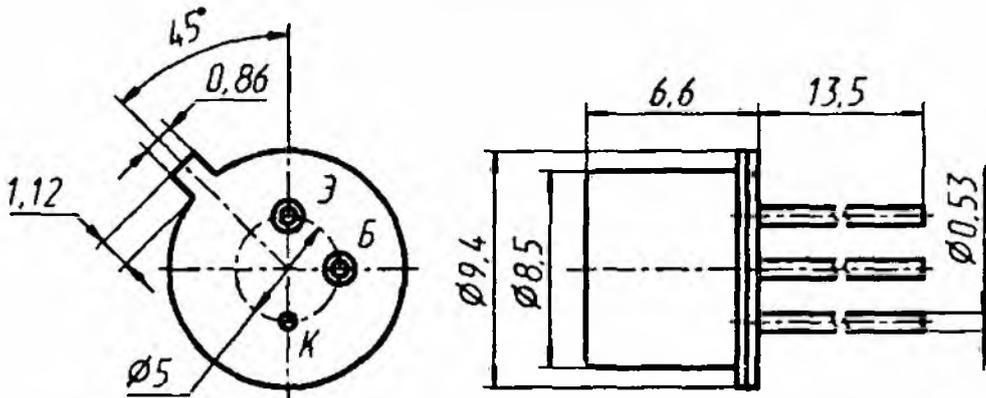


2Т653А, 2Т653Б

Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n* переключательные. Предназначены для применения в переключающих устройствах и преобразователях. Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2 г.

2Т653(А,Б)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока

при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 150$ мА:

2Т653А 40...150

 типичное значение 100*

 при $T_K = +125$ °С 40...300

2Т653Б 80...250

 типичное значение 150*

 при $T_K = +125$ °С 80...500

Граничная частота коэффициента передачи

тока при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 25$ мА 50...120*...
180* МГц

Граничное напряжение при $I_3 = 30$ мА,

$t_H \leq 300$ мкс, не менее:

2Т653А 120 В

2Т653Б 100 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА 0,3*...0,35*...
0,5 В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА 0,8*...0,85*...
1,1 В

Пробивное напряжение коллектор—эмиттер при $I_K = 0,1$ мА, $R_{ЭБ} = 3$ кОм	130...160*... 200* В
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ0} = 10$ В	6,5*...10*... 20 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ0} = 0,5$ В	40* пФ
Обратный ток коллектор—эмиттер при $R_{ЭБ} = 3$ кОм, не более:	
$U_{КЭ} = 120$ В для 2Т653А	10 мкА
$U_{КЭ} = 100$ В для 2Т653Б	10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база при $(dU/dt)_{\text{МАКС}} = 1600$ В/мкс	130 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $(dU/dt)_{\text{МАКС}} = 1600$ В/мкс, $R_{ЭБ} = 3$ кОм ...	130 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	7 В
Постоянный ток коллектора	1 А
Импульсный ток коллектора при $t_H \leq 10$ мс	2 А
Постоянный ток базы	0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора:	
при $T_K = -60...+40$ °С	5 Вт
при $T_K = +85$ °С	3 Вт
при $T_K = +125$ °С	1 Вт
при $T = -60...+25$ °С, без теплоотвода	0,8 Вт
при $T = +125$ °С, без теплоотвода	0,16 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	25 °С/Вт
Температура р-п перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-60... $T_K =$ = +125 °С

Изгиб выводов транзистора допускается не ближе 3 мм от корпуса.

Пайка выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса транзистора при температуре не выше +260 °С в течение не более 3 с.

